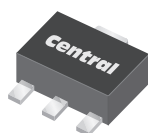


**CXDM4060P**  
**SURFACE MOUNT SILICON**  
**P-CHANNEL**  
**ENHANCEMENT-MODE**  
**MOSFET**



**SOT-89 CASE**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CXDM4060P is a high current silicon P-Channel enhancement-mode MOSFET, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This MOSFET features high current, low  $r_{DS(ON)}$ , low threshold voltage, and low gate charge.

**MARKING: FULL PART NUMBER**

**APPLICATIONS:**

- Load/Power switches
- Power supply converter circuits
- Battery powered portable equipment

**FEATURES:**

- Low  $r_{DS(ON)}$  (48m $\Omega$  TYP @  $V_{GS}=10V$ )
- High current ( $I_D=6.0A$ )
- Logic level compatibility

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ C$ )

Drain-Source Voltage  
Gate-Source Voltage  
Continuous Drain Current (Steady State)  
Maximum Pulsed Drain Current,  $t_p=10\mu s$   
Power Dissipation  
Operating and Storage Junction Temperature  
Thermal Resistance

**SYMBOL**

$V_{DS}$  40  
 $V_{GS}$  25  
 $I_D$  6.0  
 $I_{DM}$  20  
 $P_D$  1.2  
 $T_J, T_{stg}$  -55 to +150  
 $\theta_{JA}$  104

**UNITS**

V  
V  
A  
A  
W  
 $^\circ C$   
 $^\circ C/W$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ C$  unless otherwise noted)

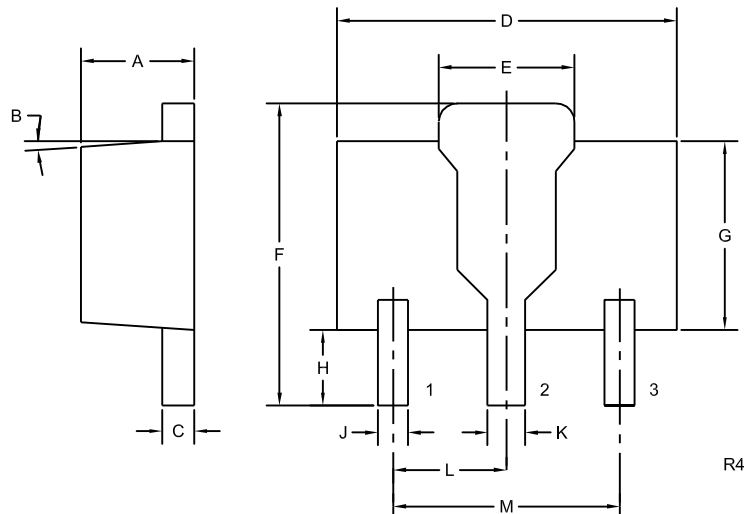
| SYMBOL              | TEST CONDITIONS                     | MIN | TYP | MAX | UNITS      |
|---------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| $I_{GSS}, I_{GSSR}$ | $V_{GS}=25V, V_{DS}=0$              |     |     | 100 | nA         |
| $I_{DSS}$           | $V_{DS}=40V, V_{GS}=0$              |     |     | 1.0 | $\mu A$    |
| $BV_{DSS}$          | $V_{GS}=0, I_D=250\mu A$            | 40  |     |     | V          |
| $V_{GS(th)}$        | $V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$       | 1.0 | 2.0 | 3.0 | V          |
| $V_{SD}$            | $V_{GS}=0, I_S=2.0A$                |     |     | 1.2 | V          |
| $r_{DS(ON)}$        | $V_{GS}=10V, I_D=6.0A$              |     | 48  | 65  | m $\Omega$ |
| $r_{DS(ON)}$        | $V_{GS}=4.5V, I_D=4.0A$             |     | 80  | 95  | m $\Omega$ |
| $C_{rss}$           | $V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz$    |     | 61  |     | pF         |
| $C_{iss}$           | $V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz$    |     | 750 |     | pF         |
| $C_{oss}$           | $V_{DS}=25V, V_{GS}=0, f=1.0MHz$    |     | 56  |     | pF         |
| $Q_{g(tot)}$        | $V_{DS}=32V, V_{GS}=4.5V, I_D=6.0A$ |     | 6.5 |     | nC         |
| $Q_{gs}$            | $V_{DS}=32V, V_{GS}=4.5V, I_D=6.0A$ |     | 3.2 |     | nC         |
| $Q_{gd}$            | $V_{DS}=32V, V_{GS}=4.5V, I_D=6.0A$ |     | 2.7 |     | nC         |
| $t_{on}$            | $V_{DS}=20V, V_{GS}=10V, I_D=1.0A$  |     | 18  |     | ns         |
| $t_{off}$           | $R_G=3.0\Omega, R_L=20\Omega$       |     | 64  |     | ns         |

R1 (28-March 2013)

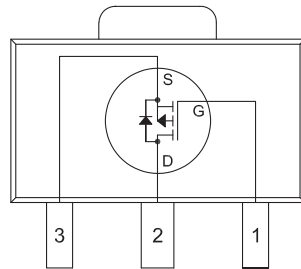
**CXDM4060P**  
**SURFACE MOUNT SILICON**  
**P-CHANNEL**  
**ENHANCEMENT-MODE**  
**MOSFET**



**SOT-89 CASE - MECHANICAL OUTLINE**



**PIN CONFIGURATION**



(Top View)  
 Tab is common to pin 2

**LEAD CODE:**

- 1) Gate
- 2) Drain
- 3) Source

**MARKING: FULL PART NUMBER**

| SYMBOL | INCHES |       | MILLIMETERS |      |
|--------|--------|-------|-------------|------|
|        | MIN    | MAX   | MIN         | MAX  |
| A      | 0.055  | 0.067 | 1.40        | 1.70 |
| B      | 4°     |       | 4°          |      |
| C      | 0.014  | 0.018 | 0.35        | 0.46 |
| D      | 0.173  | 0.185 | 4.40        | 4.70 |
| E      | 0.064  | 0.074 | 1.62        | 1.87 |
| F      | 0.146  | 0.177 | 3.70        | 4.50 |
| G      | 0.090  | 0.106 | 2.29        | 2.70 |
| H      | 0.028  | 0.051 | 0.70        | 1.30 |
| J      | 0.014  | 0.019 | 0.36        | 0.48 |
| K      | 0.017  | 0.023 | 0.44        | 0.58 |
| L      | 0.059  |       | 1.50        |      |
| M      | 0.118  |       | 3.00        |      |

SOT-89 (REV: R4)

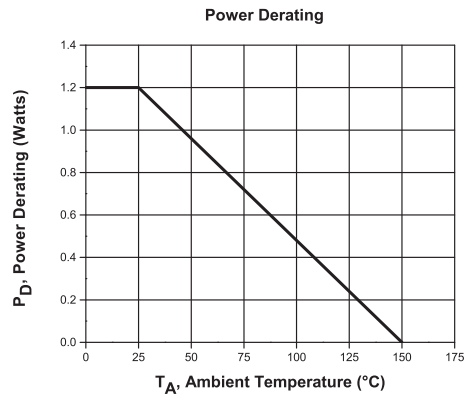
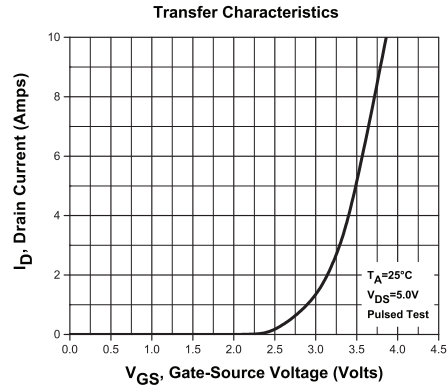
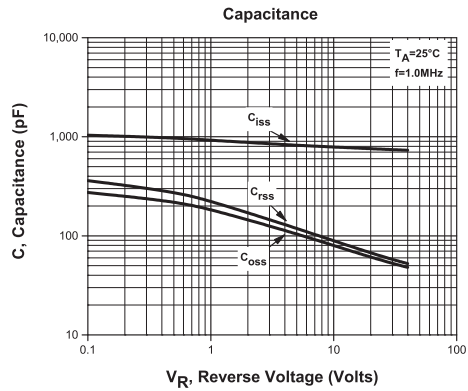
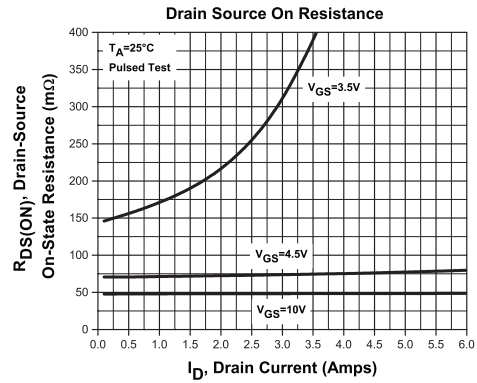
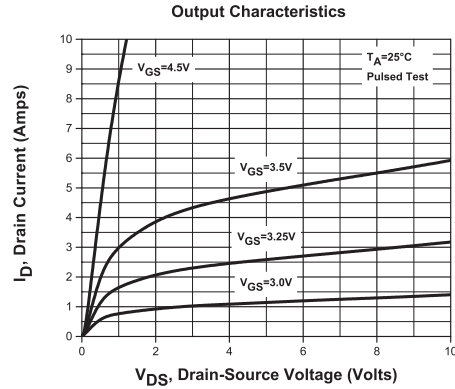
R1 (28-March 2013)

CXDM4060P

SURFACE MOUNT SILICON  
P-CHANNEL  
ENHANCEMENT-MODE  
MOSFET



## TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



R1 (28-March 2013)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9